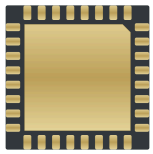
10–1100 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT ≥ 40 dBm

LCI-PA-10-1100-PS40MIN · 10–1100 MHz · GaN Amplificador de potencia encapsulado.



Valores de la tabla RF: PSAT ≥ 40 dBm; Ganancia de potencia ≥ 13 dB; PAE ≥ 60 %. Condiciones de ensayo RF: TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 23 dBm; CW.

QFN32 5 × 5 mm

Aplicar primero la polarización de puerta y después la de drenador. Al apagar, retirar primero la de drenador.

Vg: C = 10 µF

T_peak ≤ 260 °C

RFin / Vg: 4, 5

RFout / Vd: 20, 21

GND: 1, 8, 9, 16, 17, 24, 25, 32

Dimensiones del encapsulado: 5 × 5 × 1 mm.

Características RF

TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 23 dBm; CW

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	f	10	-	1100	MHz
Potencia de salida saturada	-	40	-	-	dBm
Ganancia de potencia	-	13	-	-	dB
Eficiencia de potencia añadida	-	60	-	-	%
Planitud de la ganancia de potencia	-	-	-	±0.5	dB

Polarización DC y corrientes

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Tensión de drenador	-	-	-	-	28	V
Tensión de puerta	-	-	-	-	[-3.2, -2.4]	V

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión drenador-fuente máxima	-	-	-	32	V
Polarización de puerta mínima	-	-5	-	-	V
Temperatura de almacenamiento	-	-65	-	150	°C
Potencia de entrada máxima	-	-	-	27	dBm

Dimensiones del encapsulado

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del encapsulado	5 × 5 × 1	mm

Asignación de terminales

Símbolo	Terminales	Función
GND	1,8,9,16,17,24,25,32	-
NIC	2,3,6,7,10,11,12,13,14,15,18,19,22,23, 26,27,28,29,30,31	Sin conexión interna; se puede conectar a tierra
RFin	4,5	Entrada RF / polarización de puerta
RFout	20,21	Salida RF / polarización de drenador

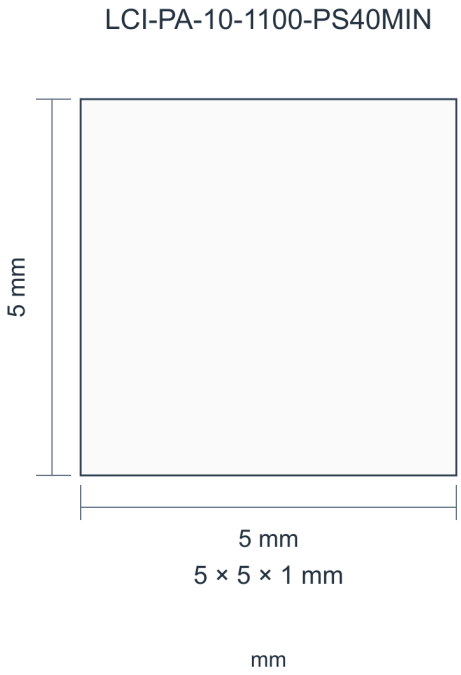
Registro de la publicación actual · 1.6 · 2026-11-12. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.5.

Notas de integración

QFN32 5 × 5 mm Aplicar primero la polarización de puerta y después la de drenador. Al apagar, retirar primero la de drenador. Vg: C = 10 µF T_peak ≤ 260 °C RFin / Vg: 4, 5 RFout / Vd: 20, 21 GND: 1, 8, 9, 16, 17, 24, 25, 32 El pad expuesto de la cara inferior del encapsulado debe conectarse a tierra RF y DC.

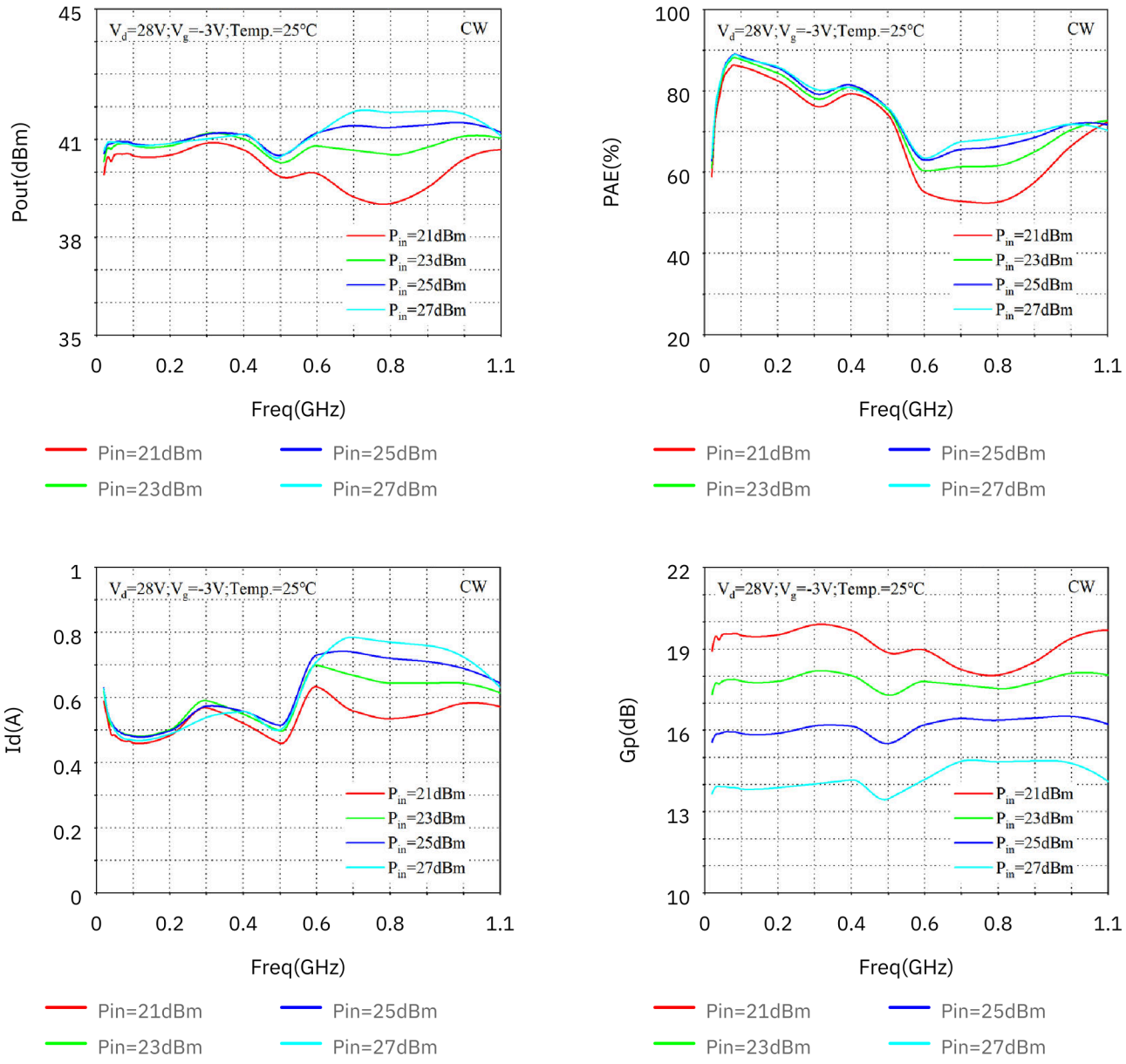
Plano dimensional mecánico

Plano parcial con cotas confirmadas en mm. Para el montaje, consulte el plano completo de instalación.



Curvas de rendimiento

Cada gráfica de rendimiento corresponde a las condiciones de funcionamiento que indica.



Potencia de salida; Eficiencia de potencia añadida; Corriente de drenador; Ganancia de potencia. Vd = 28 V; Vg = -3 V; TA = 25 °C; CW; Pin = 21/23/25/27 dBm.

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.